

ショットキバリア ダイオード  
Schottky Barrier Diodes

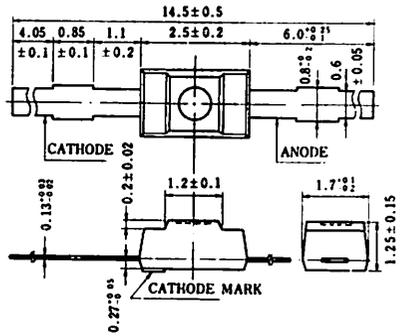
# 1SS281, 1SS281(1)

エピタキシャルショットキバリア形シリコンダイオード  
UHF ミキサ用

**特 徴**

- パッケージが小さい小形Eモードです。
- 高耐圧ショットキダイオードです。  
 $V_R = 10 \text{ V MIN.} \quad @ \quad I_R = 10 \mu\text{A}$
- $V_F$ ,  $C_i$  特性がそろっており、リングモジュレータに最適です。
- 電氣的サージに対して高信頼度です。

外形図 (単位: mm)



**絶対最大定格 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )**

項 目	略 号	定 格	単 位
逆 電 圧	$V_R$	10	V
順 電 流	$I_F$	35	mA
電 力 損 失	$P_d$	200	mW
ジャンクション温度	$T_j$	125	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	$T_{stg}$	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$
焼 損	$B_D$ *	2.0	erg

\*  $C_i = 25 \text{ pF}$

**電氣的特性 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )**

項 目	略 号	条 件	1SS281 (組品)			1SS281(1) (バラ品)			単 位
			MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	
逆 電 圧	$V_R$	$I_R = 10 \mu\text{A}$	10			10			V
逆 電 流	$I_R$	$V_R = 5.0 \text{ V}$						100	mA
順 電 圧	$V_F$	$I_F = 10 \text{ mA}$	0.46		0.55			0.55	V
端子間容量	$C_i$	$V_R = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$			1.0			1.0	pF
順電圧差 <sup>注1)</sup>	$\Delta V_F$	$I_F = 10 \text{ mA}$			10				mV
端子間容量差 <sup>注2)</sup>	$\Delta C_i$	$V_R = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$			0.2				pF

注1)  $V_F$  を 10 mV ごとに区分けして出荷

注2)  $\Delta V_F$  の同一ランク内での  $C_i$  の偏差

## 特性曲線 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

